



石墨基底上生长不同结构烷氧基铜酞菁单分子薄膜的方法



袁群惠; 王亚敏; 李守柱



2014-07-02

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及一种石墨基底上生长不同结构烷氧基铜酞菁单分子薄膜的方法,该方法中烷氧基铜酞菁为八辛氧基铜酞菁,将其溶解在有机溶剂甲苯中,配制成溶液,然后将溶液滴加到干净的高定向裂解石墨基底上,温度25°C-55°C下溶剂挥发后得到生长在石墨表面上的含两种晶型结构的八辛氧基铜酞菁单分子薄膜;而通过控制溶剂挥发温度60°C、或室温25°C下溶剂挥发后再通过温度75°C-80°C退火处理,可控制得到具有单一晶型结构的八辛氧基铜酞菁单分子薄膜。该方法得到的单分子薄膜结构中的晶型种数可调,成膜均匀,缺陷少,操作简单,温度条件温和,石墨易清洁可多次利用。通过本发明所述方法获得的石墨基底上生长的不同结构烷氧基铜酞菁单分子薄膜可用于光电分子传感器等领域。

申请日期

2014-04-05

申请号

CN201410137235.5

公开(公告)号

CN103898611A

代理机构

乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65106

文献类型

专利

条目标识符

http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/6798

专题

环境科学与技术研究室

推荐引用方式

袁群惠; 王亚敏; 李守柱. 石墨基底上生长不同结构烷氧基铜酞菁单分子薄膜的方法. CN103898611A[P]. 2014-07-02.

GB/T 7714



条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

- ★ 保存到收藏夹
- 📊 查看访问统计
- 📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

- 📖 谷歌学术中相似的文章
- 📖 [袁群惠]的文章
- 📖 [王亚敏]的文章
- 📖 [李守柱]的文章

百度学术

- 📖 百度学术中相似的文章
- 📖 [袁群惠]的文章
- 📖 [王亚敏]的文章
- 📖 [李守柱]的文章

必应学术

- 📖 必应学术中相似的文章
- 📖 [袁群惠]的文章
- 📖 [王亚敏]的文章
- 📖 [李守柱]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

